

2. 外国人研究者の受け入れ実績

(1) 附属量子エネルギー材料科学国際センター

(なし)

受入:

(2) 附属新素材設計開発施設

外国人研究員

ゼン シャンティン	2004.4.1 - 2004.9.30	受入:	後藤 孝
シンガポール	シンガポール 製造技術研究所表面技術部門長	上級研究員	
ナノコンポジットコーティングの機械的および機能的応用			

申 基三	2004.10.1 - 2005.3.31	受入:	井上 明久
韓国	国立昌原大学金属材料工学科副教授		
金属ガラスの高分解能電子顕微鏡による研究			

(3) 附属強磁場超伝導材料研究センター

(なし)

受入:

(4) 材料科学国際フロンティアセンター

外国人研究員

ツォン イグナティウス トゥン	2004.11.1 - 2004.12.31	受入:	櫻井 利夫
アメリカ	アリゾナ州立大学物理学科研究員		
シリコン表面上に於けるSiGe混晶の成長の低速電子顕微鏡観察			

シュエ チークン	2004.7.1 - 2004.9.30	受入:	櫻井 利夫
中国	中国科学院表面物理中央研究所所長		
STMによる新奇な表面現象の研究			

カン ジュンヨン	2004.7.1 - 2004.9.30	受入:	櫻井 利夫
中国	厦門大学Pen-Tung-Sha MEMS研究所 所長		
MBE-STMによる結晶物理についての研究			

ロマノフスキー ヴラジミール ロシア 超伝導体の常伝導転移における熱的安定性の理論的研究	2005.1.7 – 2005.3.31	受入:	渡辺 和雄
バスカラン ガナパシー インド 強相関電子物質の電子物性に関する理論的研究	2004.10.25 – 2004.12.23	受入:	前川 禎通
バスカラン ガナパシー インド 強相関電子系の理論的研究	2004.4.1 – 2004.6.30	受入:	前川 禎通
ハーンズ スチュワート エドワード 連合王国 磁性体の電子状態の研究	2004.4.27 – 2004.8.25	受入:	前川 禎通
ブルト ネジャット トルコ 強相関電子系の電子状態についての研究	2004.8.26 – 2004.12.25	受入:	前川 禎通
アルバニティディス イオアニス ギリシャ 負の膨張率を示すフラーレン・インターカレーション化合物の分光学的研究	2004.4.1 – 2004.6.30	受入:	岩佐 義宏
アントレーフ アレクサンドル ウラジミロビッチ ロシア ウラン化合物の純良結晶育成とその評価	2004.10.7 – 2005.1.6	受入:	塩川 佳伸
ヤバリ アライン レザ フランス 金属ガラス、過冷却液体の組織制御に関する研究	2004.10.15 – 2005.1.14	受入:	井上 明久
ホッタ フィルホ ウォルター ホセ ブラジル 非平衡物質の開発と構造解析に関する研究	2004.11.1 – 2005.1.31	受入:	井上 明久
ヤバリ アラン レザ フランス 金属ガラス、過冷却液体の組織制御に関する研究	2004.4.1 – 2004.4.26	受入:	井上 明久